



一种催化剂“种子”法制备准一维掺杂AlN阵列的方法

文献类型: 专利

作者 丛洪涛, 唐永炳 and 成会明

发表日期 2008-09-03

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 一种催化剂“种子”法制备准一维掺杂AlN阵列的方法,按0.05-3.0 g/ml的浓度,将粒径为1-3um的催化剂颗粒均匀分散在共聚物溶液中,磁力搅拌25-35分钟后形成均匀悬浮乳液后将其均匀滴在硅片上,等硅片风干后放入退火炉中在400°C-600°C情况下,通H₂保温10-30分钟去除残余聚合物,将种有催化剂颗粒的Si片,放入CVD炉中通NH₃在800-1100°C情况下,保温20-60分钟,将SiCl₄注入炉中,反应结束后大量的花形Si掺杂的AlN纳米针阵列从催化剂上长出...

公开日期 2008-09-03

语种 中文

专利申请号 CN101255064

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/66600]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 丛洪涛, 唐永炳 and 成会明. 一种催化剂“种子”法制备准一维掺杂AlN阵列的方法. 2008-09-03.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
101	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。